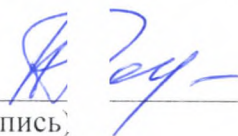


СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ

по докторской диссертации Муслимова А.Э. «Управляемая перестройка поверхности кристаллических подложек для формирования эпитаксиальных наноструктур» по специальности 01.04.18 – «Кристаллография, физика кристаллов»

Фамилия, имя, отчество оппонента	Редькин Аркадий Николаевич
Дата рождения	12 января 1956 г.
Шифр и наименование специальности, по которым защищена диссертация	05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
Ученая степень и отрасль науки	Доктор физико-математических наук (диплом серии ДЦН № 024405, приказ от 15 июля 2013 г. № 321/нк–18), электроника
Ученое звание	нет
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН)
Почтовый адрес с указанием индекса	142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д. 6, ИПТМ РАН.
Занимаемая должность	Главный научный сотрудник
Телефон	(49652) 4-40-60
Адрес электронной почты	arcadii@iptm.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<ol style="list-style-type: none"> 1. Редькин А.Н. Упорядоченные массивы наностержней оксида цинка на кремниевых подложках / А.Н. Редькин, М.В. Рыжова, Е.Е. Якимов, А.Н. Грузинцев // Физика и техника полупроводников. —2013. —Т. 47, —№ 2. —С. 216-222. 2. Sedlovets D.M. Electrical conductivity and optical properties of thin carbon films grown by pyrolysis of ethanol–water mixture vapor / D.M. Sedlovets, A.N. Redkin, V.I. Korepanov // Applied Surface Science. —2013. —V. 275. —P. 278-281. 3. Седловец Д.М. Газофазное осаждение тонких углеродных пленок из водно-спиртовых смесей / Д.М. Седловец, А.Н. Редькин, В.И. Корепанов, Г.В. Бондаренко // Известия ВУЗов. Серия: Химия и химическая технология. —2013. —Т. 56. —№ 5. —С. 9-12. 4. Грузинцев А.Н. Полевой транзистор на основе наностержней ZnO с изменяемым пороговым напряжением отсечки / А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, С. Ороку, М.Н. Шкунов // Физика и техника полупроводников.

- 2013. —Т.47. —№4. —С. 516-520.
5. Ryzhova M.V. One-step vapor deposition of ZnO nanowires/MgO film composite structures / M.V. Ryzhova, A.N. Redkin, E.E. Yakimov // Mater. Lett. —2014. —V. 136. —P. 318–321.
6. Редькин А.Н. Исследование плёнок оксида цинка, полученных в результате латерального роста упорядоченных массивов наностержней / А.Н. Редькин, М.В. Рыжова, Е.Е. Якимов, Д.В. Рошупкин // Неорган. материалы. —2015. —Т. 51. —№12. —С. 1293-1298.
7. Евстафьева М.В. Сравнение сенсорных характеристик массивов наностержней и пленок оксида цинка при облучении ультрафиолетовым светом / М.В. Евстафьева, А.Н. Редькин, Е.Е. Якимов // Нано- и микросистемная техника. —2016. —Т. 18. —№ 12. —С. 729-732.
8. Knyazev M.A. The influence of the electron-beam exposure of SiO₂/Si and quartz substrates on the selective growth of graphene-like films / M.A. Knyazev, D.M. Sedlovets, O.V. Trofimov, A.N. Redkin // Mater. Res. Bull. —2017. —V. 86. —P. 322–326.
9. Редькин А.Н. Исследование текстурированных пленок нитрида алюминия, полученных методом газофазного химического осаждения / А.Н. Редькин, М.В. Рыжова, Е.Е. Якимов, Д.В. Рошупкин // Микроэлектроника. —2017. —Т. 46. —№ 1. —С. 30–33.
10. Редькин А.Н. Газофазное осаждение слоев углеродных нанотрубок на алюминиевую фольгу / А.Н. Редькин, В.А. Кипин, Д.М. Седловец, М.А. Князев // Неорган. материалы. —2017. —Т. 53. —№ 2. —С. 132–137.
11. Старков В.В. Композитные электроды для источников тока на основе графеноподобных пленок в пористом кремнии / В.В. Старков, Д.М. Седловец, М.А. Князев, А.Н. Редькин // Физикохимия поверхности и защита материалов. —2017. —Т. 53. —№ 1. —С. 81-84.



(подпись)

Верно

Учёный секретарь
ИПТМ РАН

Дата 20.06.2018 г.


(подпись)

(И.В. Феклисова)